


	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5475DC-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI5475DC-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI5475DC-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 5.5A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 5.5A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Ta)

SI5475DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5475DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5475DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5475DC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5475DDC Vishay SI5475DDC Vishay</p>	 <p>SI5475DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>	 <p>SI5475BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5475DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>
 <p>SI5475DDC-T1-E3 VISHAY VISHAY 1206-8</p>	 <p>SI5475DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8</p>	 <p>SI5475BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5475DC-T1 VISHAY SI5475DC-T1 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5475DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI5475DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5475DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5475DC-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5475DC-T1-GE3
SI5475DC-T1-GE3 Electronic	SI5475DC-T1-GE3-Komponenten	SI5475DC-T1-GE3-Verteiler	SI5475DC-T1-GE3-Bild	SI5475DC-T1-GE3-Teil
SI5475DC-T1-GE3 Preis	SI5475DC-T1-GE3 Hersteller	SI5475DC-T1-GE3 Bild	SI5475DC-T1-GE3 Aktie	SI5475DC-T1-GE3 Inventar
SI5475DC-T1-GE3 Neu	SI5475DC-T1-GE3 Original	SI5475DC-T1-GE3 garantiert	SI5475DC-T1-GE3 RFQ	SI5475DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited